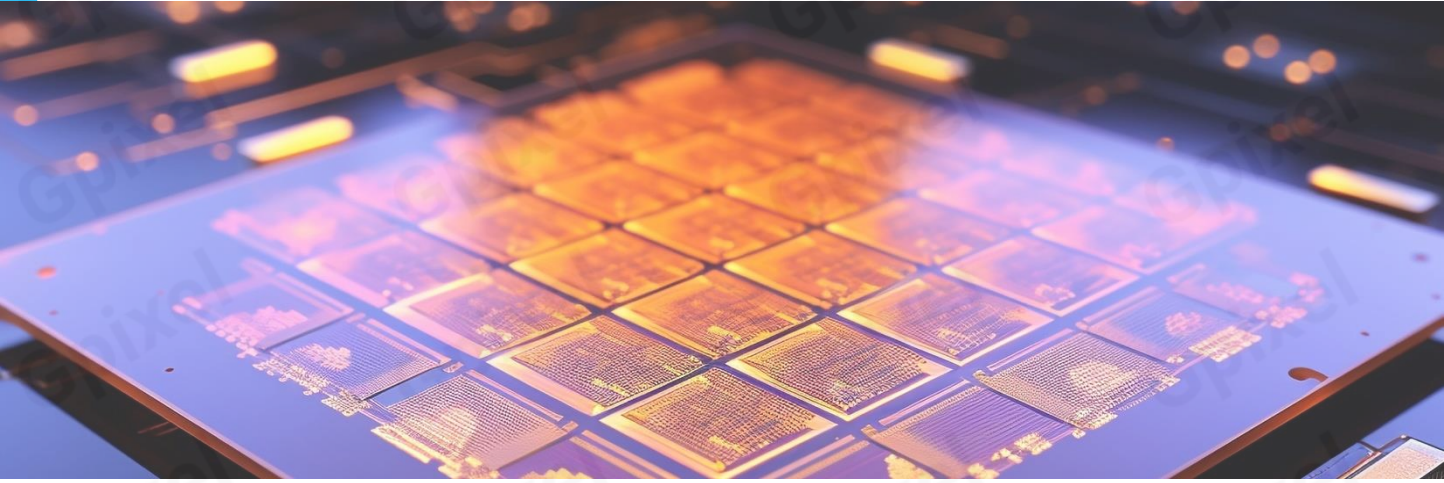
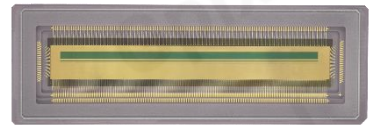


GLT5008BSI 产品彩页



8K 背照式CMOS TDI图像传感器

GLT5008BSI 是一款背照式(BSI)、时延积分 (TDI)、电荷域CMOS图像传感器，水平方向有效分辨率为8208，像素尺寸为5 μm ，最高满阱17ke⁻，具有优异的anti-blooming能力以及大于0.99993的电荷转移效率 (CTE)，峰值量子效率为93.4% @ 440 nm，得益于先进的背照式工艺和紫外量子效率优化工艺，在266 nm处的量子效率大于63.9%。同时，GLT5008BSI片上集成双谱段，级数分别为256级和32级，可通过HDR合成进一步提升动态范围。GLT5008BSI支持10 bit和12 bit ADC输出，对应的最大行频分别为1M Hz和500k Hz，10 bit最高行频下功耗<4.2 W，为确保高可靠性和良好的散热性能，其采用231引脚的 μPGA 陶瓷封装。GLT5008BSI具备高分辨率、高灵敏度、高帧频、低功耗等优异性能，同时片上集成了时序控制模块和电源管理模块，支持通道合并、可选扫描方向等功能，为基因测序、半导体检测、屏幕检测等应用带来更加准确、简单、高效的解决方案。



产品特性

- 双感光谱段
- 像素尺寸: 5 μm
- 背照式、TDI
- 高灵敏度
- 双谱段HDR
- 峰值量子效率: 63.9% @ 266 nm、93.4% @ 440 nm

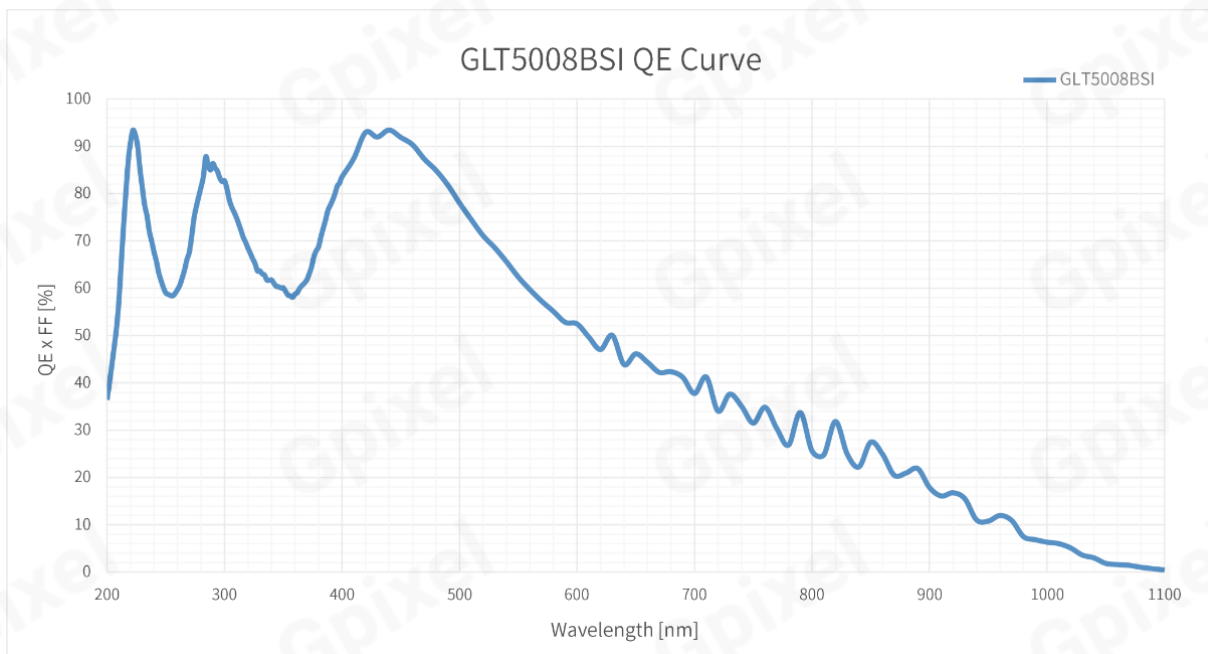
应用领域

- 平板显示器检测
- PCB检测
- 晶圆检测
- 荧光显微成像
- 医疗

产品指标

像素尺寸	5 μm x 5 μm	色彩	黑白
分辨率	P1: 8208 pixels x 256 stages P2: 8208 pixels x 32 stages	感光面长度	41.04 mm
满阱容量	17 ke ⁻ @ 10 bit	读出噪声	14.3 e ⁻ @ 10 bit
动态范围	61.5 dB @ 10 bit	暗电流	4.6 ke ⁻ /pixel/s @ 11.9 °C
量子效率	63.9% @ 266 nm 93.4% @ 440 nm	ADC位数	10/12 bit
电荷转移效率 (CTE)	≥ 0.99993	可选TDI级数	P1: 256/252/224/192/128/64/32/4 P2: 32/30/28/24/16/8/4/2
Anti-blooming	x50	最高行频	1M Hz @ 10 bit 500k Hz @ 12 bit
输出接口	72 对 Sub-LVDS	功耗	4.2 W
最大数据率	86.4 Gbps @ 10 bit	通道合并	72/54/48/36/24/18/12/6 @ 10 bit
供电电压	3.3 V (模拟)、1.65 V (ADC) 1.6 V (数字)	封装形式	μPGA 231 pins (56.90 mm x 19.00 mm)

QE曲线



联系方式

长光辰芯 (总部)

地址: 吉林省长春市经济技术开发区自由大路7691号, 光电信息产业园一期5号办公楼
电话: +86-0431-85077785

长光辰芯 (杭州子公司)

地址: 浙江省杭州市滨江区建业路599号华业发展中心31层3101-3109室
电话: +86-571-87718606-888

长光辰芯 (大连子公司)

地址: 辽宁省大连市高新技术产业园区汇贤园7号11层#05D室
电话: +86-0411-39937666



更多联系方式